



Transistor NPN de Alta Frecuencia / 30-500 MHz / 28 Vcc / 10 dB / 125 W / Push-Pull

SKU: MRF392 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$1,510.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transistor NPN de silicio diseñado para aplicaciones de alta frecuencia en el rango de 30 a 500 MHz. Integra dos transistores en configuración push-pull con emisores comunes, optimizando el rendimiento en sistemas de amplificación de RF. Ofrece una potencia de salida de 125 W a 400 MHz con ganancia de 10 dB y eficiencia del 55%, incluyendo redes de adaptación de impedancia integradas que simplifican el diseño de circuitos.

Características Principales

- Transistor NPN de silicio para alta frecuencia
- Rango operativo: 30-500 MHz
- Tensión colector-emisor: 28 Vcc
- Ganancia: 10 dB con eficiencia del 55%
- Potencia de salida: 125 W a 400 MHz
- Doble transistor en encapsulado push-pull
- Configuración de emisores comunes
- Redes de adaptación de impedancia integradas
- Metabolización de oro

Especificaciones Técnicas

VSWR 30:1 sin degradación	Máximos Permisibles
VEBO: 4.0 VDC	IC: 16 A DC
PD: 270 W (a TC = 25°C)	Derate: 1.54 W/°C
TSTG: -65 a +150 °C	TJ: 200 °C

Características Térmicas

RθJC: 0.65 °C/W	Características Eléctricas
HFE: 40-100 (a IC = 1.0 A DC)	Características de Operación
COB: 75-95 pF	Ganancia: 8-10 dB
	Eficiencia: 50-55%
	VSWR: 30:1 sin degradación
	Impedancia: 20 Ω

Configuración

Dos transistores en un solo encapsulado

Emisores comunes

Redes de adaptación de impedancia integradas

Metabolización de oro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble transistor en encapsulado push-pull integrado
Característica 2	Redes de adaptación de impedancia incorporadas
Característica 3	Metabolización de oro para mayor confiabilidad
Característica 4	Operación estable con VSWR 30:1 sin degradación
Característica 5	Eficiencia del 50-55% en amplificación de RF
Característica 6	Rango térmico extendido de -65°C a +150°C